

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0105U006929

Відкрита

Дата реєстрації: 02-11-2005

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
-----	--------------

2. Замовник

Назва організації: Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00027677

Адреса: пр. Перемоги, 10, м. Київ, Київ, 01135, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів

Телефон: 0442878922

Телефон: 0442878922

E-mail: mon@mon.gov.ua

WWW: <https://mon.gov.ua/ua>

3. Виконавець

Назва організації: Інститут електронної фізики НАНУ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540008

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: вул.Університетська,21, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88017, Україна

Телефон: 43650

Інше: 43650

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ GaAs ПОВІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ

Назва роботи (англ)

EXCITATION OF GaAs ELECTRON STATES BY SLOW ELECTRONS

Мета роботи (укр)

Встановлення закономірностей пружного і непружного зворотного (на 180°) розсіювання моноенергетичних (10-30 меВ) електронів поверхнею арсеніду галія та дослідження його поверхневої й об'ємної електронної енергетичної структури в області енергій 0-5 еВ.

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: В результаті проведених досліджень буде встановлено закономірності пружного і непружного зворотного (на 180°) розсіювання повільних (0-5 еВ) моноенергетичних (10-30 меВ) електронів поверхнею арсеніду галія і виявлено особливості густини розподілу його об'ємних і поверхневих електронних енергетичних станів.

Галузь застосування:

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	11.2004	10.2005	Остаточний звіт	Вивчення процесів збудження електронних станів GaAs(111) повільними електронами та дослідження його електронної енергетичної структури методом спектроскопії зворотного розсіювання електронів низьких енергій.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.29.15

Індекс УДК: 539.182/.184;535.33/.34, 539.186, 539.188

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Шпеник Отто Бартоломійович

Керівники роботи:

Фейер Віталій Михайлович

Відповідальний за подання документів: (Тел.:)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.